## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

06-224163

(43) Date of publication of application: 12.08.1994

(51)Int.CI.

H01L 21/302 G02F 1/136 H01L 21/205

H01L 29/784

(21)Application number: 05-010524

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

26.01.1993

(72)Inventor: WATANABE KUNIHIKO

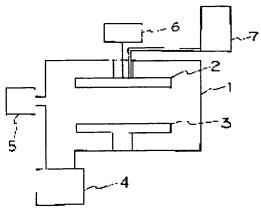
TANAKA MASAHIRO TODOROKI SATORU SHIMAMURA MASAKI

## (54) SELF-CLEANING METHOD FOR VACUUM CHAMBER

### (57) Abstract:

PURPOSE: To enable the self-cleaning end point of a plasma deposit apparatus to be stably and accurately detected by a method wherein the self-cleaning end point of a vacuum chamber provided inside the plasma deposit apparatus is detected through a measurement of pressure taken by a mass spectrometer or a vacuum gauge or a pressure gauge.

CONSTITUTION: An end point detecting method, wherein process parameters reflecting from data throughout all vacuum chamber of a plasma deposit apparatus are measured, is adopted. That is, strong process parameters comparatively small in space dependency such as emission spectrum change and the film thickness change of a specific part with time are measured, whereby the end point of self-cleaning is detected. For instance, the mass spectrometric analysis of processing gas inside the vacuum chamber 1 is executed by the use of a quadrupole mass spectrometer



5. Or, the change of pressure is measured by a diaphragm gauge, whereby the end point of self-cleaning is detected. Thus, the end point of self-cleaning can be stably and accurately detected without taking the size of the vacuum chamber and the spatial distribution state of works into consideration.

### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

26.03.1999

[Date of sending the examiner's decision of

05.12.2000

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平6-224163

(43)公開日 平成6年(1994)8月12日

(51)Int.Cl. <sup>5</sup>	識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
H01L 21/302	N	9277-4M		
	Е	9277-4M		
G 0 2 F 1/136	500	9018-2K		
H 0 1 L 21/205				
		9056-4M	H 0 1 L	29/ 78 3 1 1 F.
		審査請求	未請求 請求項	[の数15 OL (全 7 頁) 最終頁に続く
(21)出願番号	<b>特願平5-10524</b>		(71)出願人	000005108
()				株式会社日立製作所
(22)出願日	平成5年(1993)1月	<b>∃26</b> 日		東京都千代田区神田駿河台四丁目 6番地
			(72)発明者	渡邉 邦彦
				横浜市戸塚区吉田町292番地株式会社日立
				製作所生産技術研究所内
			(72)発明者	田中 政博
				横浜市戸塚区吉田町292番地株式会社日立
				製作所生産技術研究所内
			(72)発明者	
				横浜市戸塚区吉田町292番地株式会社日立
				製作所生産技術研究所内
			(74)代理人	弁理士 小川 勝男
				最終頁に続く

## (54)【発明の名称】 真空容器内セルフクリーニング方法

### (57)【要約】

【目的】プラズマ堆積装置のセルフクリーニング終点検 出を、安定かつ正確に行なうこと。

【構成】プラズマ堆積装置のセルフクリーニング終点検 出を、真空容器内の情報をもれなく反映するプロセスパ ラメータで行なう。具体的には、クリーニング中の真空 容器内雰囲気の質量分析を行ない、特定な信号強度の経 時変化から終点検出する方法、圧力の変化から終点検出 する方法があり、各々四重極型質量分析計等、圧力計等 で測定する。

【効果】真空容器の大きさ、形状、非処理物の空間分布 状態、測定装置の位置、空間分解能等を考慮することな く、安定かつ正確なセルフクリーニング終点検出が簡便 に行なえる。また、その場観察にも適している。

